T-27-15

2\$B851 2\$B1278

エピタキシァルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ中電力増幅用/Medium Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors

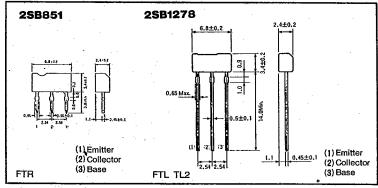
● 特長

- 1) 小型FTRパッケージにてPc=750mW である。
- 2) V_{CEO}=-80Vと高耐圧である。

Features

- Compact FTR package delivering high power: P_C=750mW
- 2) High breakdown voltage: V_{CEO}=-80V

● 外形寸法図/Dimensions (Unit:mm)



注:FTLの外形仕様については、TL3/4タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit	
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	80	٧	
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	-80	V	
エミッタ・ベース間電圧	VEBO -5		V	
コレクタ電流	lo	-700	mA	
コレクタ損失	Pc	750	mW	
接合部温度	τj	150	°C	
保存温度範囲	Tstg	-55~150	င	

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions	
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	-80	_		٧	I _C =-2mA	
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{ÇBO}	-80	_		٧	Ic=-50µA	
エミッタ・ベース降伏電圧	BVEBO	5	_	_	٧	Ι _Ε =-50μΑ	
コレクタしゃ断電流	Гсво	-	-	-0.5	μА	V _{CB} =-50V	
エミッタしゃ断電流	lebo		-	-0.5	μА	V _{EB} =-4V	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}		-0.2	-0.4	٧	Ic/IB=-500mA/-50mA	
直流電流増幅率	h FE	82	-	390	-	Vce /1c=-3V/-100mA	
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f _T		100	-	MHz	VcE =-10V, I _E =50mA	
出力容量	Cob	_	14	20	рF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz	

hfEの値により下表のように分類します。

Item	Р	Q	R
h FE	82~180	120~270	180~390

標準品・準標準品一覧表

10	接淮口	\circ	進標進品
(C)	標準品	():	连模连码

-		包装名 バル・		エテナ	テー	ピング
		記号		C1	TL2	TL3
Туре	hFE	基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SB851	PQR		0	0	_	
2SB1278	PQR		-		0	0

196

ROHIT

T-27-15

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

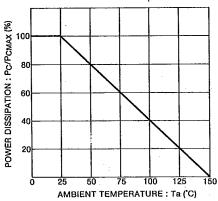
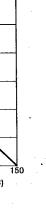
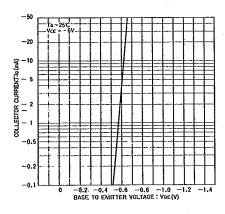


Fig.1 電力軽減曲線





. Fig.3 エミッタ接地伝達静特性

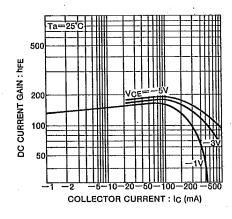


Fig.5 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

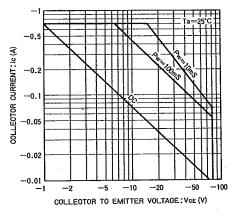
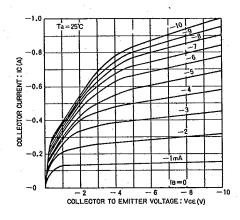


Fig.2 安全動作領域



エミッタ接地出力静特性

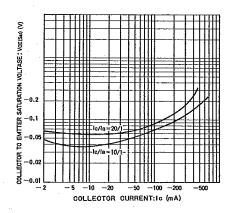


Fig.6 コレクタ・エミッタ飽和電圧 -- コレクタ電流特性

ROHM

197

2SB851/2SB1278

T-27-15

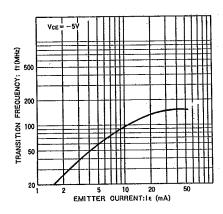


Fig.7 利得帯域幅積-エミッタ電流特性

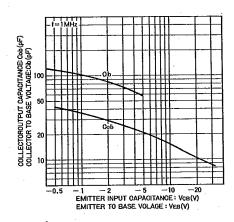


Fig.8 コレクタ出力容量―コレクタ・ベース電圧特性 エミッタ入力容量―エミッタ・ベース電圧特性

198

ROHE